

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu		9+25	
		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
2		Cu		18	
		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
3		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		18	
4		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
		Prepreg	0.048		106
5		Prepreg	0.048		106
		Cu		18	
		Tr-Lam	0.10		
6		Cu		18	
		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
7		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		18	
8		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
		Prepreg	0.048		106
9		Prepreg	0.048		106
		Cu		18	
		Tr-Lam	0.10		
10		Cu		18	
		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
11		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		18	
12		Tr-Lam	0.10		
		Cu		18	
		Prepreg	0.048		106
13		Prepreg	0.048		106
		Cu+galv.Cu		9+25	
14					

Presslingsdicke *	1,53	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	1,64	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm
	Viapad-Ø	≥ 350 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm